МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" Набережночелнинский институт (филиал) Отделение информационных технологий и энергетических систем Кафедра физики

Н.Б.Юнусов И.К.Хафизов «Оптика»

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ФОТОЭФФЕКТА

Методические указания к лабораторной работе по физике

г. Набережные Челны 2019 г.

УДК 530 (077)

Оптика: Изучение явления фотоэффекта: Методические указания к лабораторной работе по физике. Составители **Юнусов Н.Б. Хафизов И.К.** г. Набережные Челны: НЧИ КФУ, 2019 г., стр. 8.

Методические указания предназначены в помощь студентам дневного и заочного отделений НЧИ КФУ. Рассматривается явление внешнего фотоэффекта, изучается работа фотоэлемента. По результатам измерений определяются вольтамперная и спектральная характеристики фотоэлемента. Ил. - 3; Табл. - 2; Список лит. - 3 назв.

Рецензент: д.т.н., профессор кафедры ММиТЭ А.К.Розенцвайг.

Печатается по решению Учебно-методической комиссии отделения информационных технологий и энергетических систем Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Цель работы: 1. Изучение законов внешнего фотоэффекта.

- 2. Ознакомление с явлением внешнего фотоэффекта.
- 3. Получение вольтамперной характеристики фотоэлемента.
- 4. Получение спектральной характеристики ФЭ.

Приборы и принадлежности: фотоэлемент, вольтметр, микроамперметр, источник света с набором светофильтров, источник питания.

І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ

Внешним фотоэлектрическим эффектом или просто фотоэффектом называют испускание электронов веществом под действием света.

Опытным путём были установлены три закона внешнего фотоэффекта:

- 1. Максимальная начальная скорость $v_{\rm M}$ фотоэлектронов не зависит от интенсивности света, а определяется только его частотой.
- 2. Для каждого вещества существует «красная граница» фотоэффекта, т.е. такая наименьшая частота v_{θ} при которой ещё возможен фотоэффект («красной» эта граница называется потому, что при частотах v, меньших, чем v_{θ} , фотоэффект не наблюдается).
- 3. Фототок насыщения прямо пропорционален интенсивности падающего на катод света.

Законы внешнего фотоэффекта были объяснены А.Эйнштейном в 1905 году в его квантовой теории света. Опираясь на квантовую идею М.Планка, А. Эйнштейн пришёл к выводу, что излучение не только испускается и поглощается, но и распространяется в пространстве в виде отдельных порций энергии - квантов электромагнитного поля (фотонов).

В монохроматическом свете с частотой v все фотоны имеют одинаковую энергию, равную hv, где h - постоянная Планка, равная $6.62\cdot 10^{-34}$ Дж·с.

Известно, что для выхода из металла электрон должен преодолеть потенциальный барьер на границе металл-вакуум, т.е. совершить работу выхода A_0 . Пусть при падении фотона на электрон его энергия hv целиком передаётся электрону. Если $hv \geq A_0$, то электрон сможет завершить работу выхода и выйти из металла.

Согласно закону сохранения энергии, энергия поглощённого фотона расходуется на совершение электроном работы выхода A_0 и приобретение им максимальной кинетической энергии

$$\frac{mv_{M}^{2}}{2}: hv = A_{0} + \frac{mv_{M}^{2}}{2}. (1)$$

Уравнение (1) называется уравнением Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Из него следует, что максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона (а следовательно, и $v_{\rm M}$) зависит от частоты света и работы выхода A_0 , но не зависит от интенсивности света. Это и есть 1-й закон фотоэффекта.

Из этого же уравнения следует, что внешний фотоэффект возможен лишь при условии $hv \ge A_0$. Энергии фотона должно хватить, по меньшей мере, на то, чтобы вырвать электрон из металла, не сообщая ему кинетической энергии $(v_{\rm M}\!\!=\!\!0)$. С учётом вышеуказанного получаем из (1) для «красной границы»

фотоэффекта:
$$v_0 = \frac{A_0}{h}.$$
 (2)

Таким образом объясняется второй закон фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта зависит только от работы выхода, т.е. от химической природы металла и состояния его поверхности. «Красной границей» называют также максимальную длину световой волны λ_0 при которой еще возможен фотоэфект:

$$\lambda_0 = \frac{c}{v_0} = \frac{hc}{A_0}. (3)$$

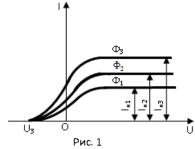
Квантовый характер взаимодействия света с веществом проявляется и в безынерционности фотоэффекта: при освещении поверхности светом с частотой $v \ge v_0$ фототок возникает практически мгновенно.

Общее число фотоэлектронов n, покидающих поверхность металла за единицу времени, должно быть пропорционально числу фотонов n', падающих за то же время на поверхность, то есть интенсивности света. Если все n электронов, вылетающих из катода в единицу времени, попадают на анод, то приходим к третьему закону фотоэффекта: ток насыщения $I_H = n \cdot e$ пропорционален числу фотонов n', ежесекундно падающих на катод, т.е. интенсивности света.

Всё сказанное выше относится к случаю, когда электрон металла поглощает только один фотон. При очень больших ин-

тенсивностях света, например, при облучении металла лазерным излучением, электрон может получить энергию при одновременном попадании в него нескольких одинаковых фотонов. В этом случае законы фотоэффекта нарушаются.

Внешний фотоэффект исследуется в схемах с вакуумным или газонаполненным фотоэлементом. Зависимость фототока I фотоэлемента от приложенного к электродам напряжения U при постоянном световом потоке Φ называется вольтамперной характеристикой (рис. 1).



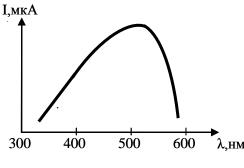
Особый интерес представляет напряжение U_3 , называемое задерживающим, при котором фототок I прекращается. По величине U_3 может быть определена максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_{\rm M}$:

$$E_{\scriptscriptstyle M} = \frac{m \upsilon_{\scriptscriptstyle M}^2}{2} = e U_{\scriptscriptstyle 3} \,, \tag{4}$$

где e - заряд электрона; m - масса электрона.

При увеличении светового потока Φ , падающего на катод ($\Phi_1 \!\!<\!\! \Phi_2 \!\!<\!\! \Phi_3$), возрастает и ток насыщения : $I_{{\scriptscriptstyle {\rm H}}} \!\!<\! I_{{\scriptscriptstyle {\rm H}}} \!\!<\! I_{{\scriptscriptstyle {\rm H}}} \!\!<\! I_{{\scriptscriptstyle {\rm H}}}$ (рис.1).

Зависимость фототока I от длины волны монохроматического излучения λ называется спектральной характеристикой (рис.2).



Рис₅2

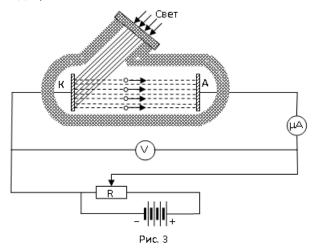
Характерной особенностью спектральной кривой является наличие «красной границы» — резкого обрыва кривой в области больших длин волн ($\lambda > 500$ нм). Падение величины фототока в области малых длин волн вызвано поглощением света в стеклянном окошке баллона $\Phi \Theta$.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Конструктивно установка состоит из трёх частей:

- 1. Источника постоянного тока.
- 2. Источника света с набором светофильтров и фотоэлемента.
- 3. Измерительного блока, на передней панели которого расположены измерительные приборы, переключатель и потенциометр. На боковой панели блока имеются два гнезда для подключения.

Схема экспериментальной установки для изучения Φ Э приведена на рис.3. В лабораторной установке используется вакуумный фотоэлемент. Он представляет собой стеклянный баллон, половина поверхности которого покрыта слоем металла (фотокатод K).



Выбиваемые светом из катода K электроны устремляются к аноду A, на который подан положительный потенциал. Фотоэлемент помещён во фторопластовый корпус, прикреплённый к корпусу диафрагмы окуляра осветителя.

С помощью штекеров фотоэлемент подсоединяется к измерительному блоку. Напряжение между электродами, измеря-

емое вольтметром V, можно изменять потенциометром R. Микроамперметр μA служит для регистрации фототока.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подготовка установки к работе:

- 1. Установите рычажок диафрагмы окуляра осветителя в крайнее правое положение, что соответствует минимальному световому потоку $\Phi_{\text{мин.}}$
- 2. Потенциометр R на передней панели измерительного блока установите в крайнее правое положение, что соответствует минимальному напряжению U на Φ 9.
- 3. Переключатель измерительного блока установите в положение 1.
- 4. Включите в сеть осветитель.
- 5. Включите источник питания.

Задание 1. Снятие вольтамперной характеристики фотоэлемента и изучение зависимости силы тока насыщения $I_{\rm H}$ от величины падающего на катод K светового потока Φ .

- 1. Установите максимальное значение светового потока $\Phi_{\text{мак.}}$ поворотом влево рычажка диафрагмы.
- 2. С помощью потенциометра R изменяйте напряжение U и заносите значения U и силы тока I в таблицу 1.
- 3. С помощью рычажка диафрагмы изменяйте световой поток Φ и повторите пункт 2 ещё для двух значений светового потока $\Phi_{\text{сред.}}$ и $\Phi_{\text{мин.}}$.

Таблица 1.

Интенсивность	U,B						
света $\Phi_{\text{мак.}}$	I,µA						
Интенсивность	U,B						
света $\Phi_{ ext{cpeд.}}$	I,µA						
Интенсивность	U,B						
света $\Phi_{\text{мин.}}$.	I,µA						

<u>Задание 2.</u> Снятие спектральной характеристики фотоэлемента.

- 1. Выставьте с помощью потенциометра R значение $U \approx 100 \text{B}$.
- 2. С помощью диафрагмы выставьте максимальное значение светового потока $\Phi_{\text{мак}}$.
- 3. По очереди вставляйте в карман фонаря осветителя светофильтры и заносите в таблицу 2 значения фототока I.

Светофильтр (<i>λ</i> ,нм)	УФС	Жёлтый	Оранжевый	Красный
	365	550	600	650
I,µA				

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- 1. По данным таблицы 1 постройте вольтамперные характеристики фотоэлемента для различных уровней светового потока, падающего на катод: $\Phi_{\text{мак}}$, $\Phi_{\text{срел}}$, $\Phi_{\text{мин}}$.
- 2. Из значений силы тока насыщения $I_{\rm H}$ определите число электронов n, ежесекундно падающих на анод.
- 3. По данным таблицы 2 постройте спектральную характеристику фотоэлемента.
- 4. Письменно прокомментируйте полученные результаты.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Дайте определение внешнего фотоэффекта.
- 2. Нарисуйте вольтамперную характеристику фотоэлемента и объясните её.
- 3. Сформулируйте законы внешнего фотоэффекта.
- 4. В чём суть гипотезы А.Эйнштейна для объяснения фотоэффекта?
- 5. Запишите формулу А.Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Объясните с её с помощью законы фотоэффекта.
- 6. Дайте определения «красной границы» фотоэффекта, работы выхода электрона и задерживающей разности потенциалов.
- 7. Нарисуйте схему для снятия вольтамперной характеристики фотоэффекта.

6. ЛИТЕРАТУРА

- 1. Савельев И. В. Курс общей физики [Электронный ресурс]: учебник в 3 томах / И. В. Савельев. -Санкт-Петербург: Лань, 2011. Т.3. Квантвая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 318 с. ISBN
- 978-5-8114-0632-6. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2040.

- 2. Трофимова Т.И. Курс физики [Текст] : учебное пособие для инженерно-технических специальностей вузов /Т.И. Трофимова.
- 10-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург : АТП, 2016. 560 с. : ил. (Высшее проф. образование). Рек. МО. В пер. ISBN 5-7695-1870-5.
- 3. Лабораторный практикум по физике. / Под редакцией А.С.Ахматова.- М.: Высшая школа, 1980.